DEL 2004

JAN 1 4,2004



特許協力条約

PCT

国際予備審查報告 Internatinoal Preliminary Examination Report (法第12条、法施行規則第56条)

(PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 NE+03P112	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/08360	国際出願日 (日.月.年) 01.07.03	優先日 (日.月.年) 02.07.02			
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' H01L21/205	, C23C16/01, C23C16/3	34, C30B29/38			
出願人 (氏名又は名称) 日本質	(日.月.年) 01.07.03 (日.月.年) 02.07.02 (日.月.日) 02.07.02 (日.				
1. 国際予備審査機関が作成したこの目	国際予備審査報告を法施行規則第57条(P	CT36条) の規定に従い送付する。			
2. この国際予備審査報告は、この表系	ほを含めて全部で 3 ペー	ジからなる。			
査機関に対してした訂正を含む	β明細冉、請求の範囲及び/又は図面も添 実施細則第607号参照)				
3. この国際予備審査報告は、次の内容	?を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎		· ·			
Ⅱ □ 優先権	•	•			
Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	Ⅲ				
IV 発明の単一性の欠如		•			
	トる新規性、進歩性又は産業上の利用可能	性についての見解、それを裏付けるため			
の文献及び説明 VI bる種の引用文献		,			
VII 国際出願の不備	: .				
WI 国際出願に対する意見					
		·			
•	·				

国際予備審査の請求書を受理した日 01.07.03	国際予備審査報告を作成した日 15.12.03
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 4R 8831 池渕 立 電話番号 03-3581-1101 内線 3469

国際予備審查報告

I.	3	目際予備審査報	8告の基礎			
1.	戌		こ提出された差し替え用紙は			14条)の規定に基づく命令に 報告書には添付しない。
		出願時の国際	祭出願書類			
	X	明細書 明細書 明細書	第 <u>1-29</u> 第 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と 27.11.03	らづき補正されたもの : 共に提出されたもの
	X	図面 図面	第 <u>1/5-5/5</u> 第	ページ /図 、 ページ/図、 ページ/図、		
		明細書の配列	刑表の部分 第 刑表の部分 第 刑表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と 	
2.	ل	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合	を除くほか、この	の国際出願の言語である。	
•	١	上記の書類は、	下記の言語である	語である	ప .	
]]]	РСТ規	のために提出されたPCT .則48.3(b)にいう国際公開の 審査のために提出されたP	言語		語
з.	3	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んで:	おり、次の配列表に基づき	き国際予備審査報告を行った。
]]]	□ この国後にに の原後後後後 出出出事の面あ がある面あった	があった る配列表に記載した配列と 。	ディスクによる配 は調査)機関に抵 は調査)機関に抵 が出願時における	是出された 魯面による配列 と出された磁気ディスクに の国際出願の開示の範囲を	
4.		爾正により、 明細書 請求の範囲 図面	下記の書類が削除された。 第 第 _30 図面の第	ページ 項 ペー	ジ/図	
5.		れるので、		つとして作成した	。(PCT規則70.2(c)	範囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上
						·



国際出願番号 PCT/JP03/08360

見解		
新規性(N)	請求の範囲 1-29, 31, 32 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-29,31,32</u> 請求の範囲	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-29,31,32</u> 請求の範囲	

文献 1 : EP 1271627 A2 (NEC CORPORATION) 2003.01.02 文献 2 : JP 2003-178984 A (日本電気株式会社) 2003.06.27

文献 3: JP 2002-343718 A (松下電器産業株式会社) 2002.11.29 文献 4: JP 2002-050585 A (日立電線株式会社) 2002.02.15 文献 5 : JP 2001-223165 A (日立電線株式会社) 2001.08.17

請求項1-29、31、32について 金属元素含有膜上に接して空隙部を含む I I I 族窒化物半導体層を形成する工程を 有する I I I 族窒化物半導体基板の製造方法については、本願出願と同一出願人によ る文献1,2を除いて、国際調査報告に列記した何れの文献にも記載されておらず、 当業者にとっても自明のものとは認められない。